



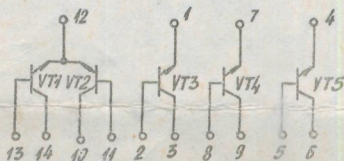
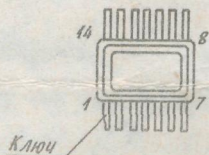
Микросхемы типа  
198НТ1, 198НТ2, 198НТ3  
соответствуют  
техническим условиям  
О.348.002 ТУ

### Э Т И К Е Т К А

Матрица транзисторов п-р-п типа

Схема расположения выводов

Схема электрическая принципиальная  
для 198НТ1



Для 198НТ2 - без транзистора VT4

Для 198НТ3 - без транзистора VT1

Масса не более 0,8 г

Содержание драгоценных металлов в 1000 шт микросхем

ЗОЛОТО

**0,8730 Г - Ср 999,9**

СЕРЕБРО

Г

**8,5311 Г - Зл 999,9**

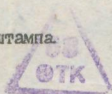
ДЕК 1988

32

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ при  $T = 25 \pm 10^\circ\text{C}$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквен- ное обозна- чение	198НТ1А 198НТ2А		198НТ1Б 198НТ2Б		198НТ3	
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более
Статический коэффициент передачи тока транзистора (при $U_{\text{КБ}}=3\text{В}, I_{\text{Э}}=0,5\text{мА}$ )	$h_{21Э}$	30	200	30	200	30	200
Обратный ток коллектора (при $U_{\text{КБ}}=6\text{В}$ ), мкА	$I_{\text{КБО}}$	-	0,05	-	0,05	-	0,05
Напряжение насыщения база-эмиттер (при $I_{\text{К}}=3\text{мА},$ $I_{\text{Б}}=0,5\text{мА}$ ), В	$U_{\text{БЭнас}}$	-	0,8	-	0,8	-	0,8
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (при $I_{\text{К}}=3\text{мА}, I_{\text{Б}}=0,5\text{мА}$ ), В	$U_{\text{КЭнас}}$	-	0,2	-	0,2	-	0,1
Разброс статических коэффициентов передачи тока транзисторов диф- ференциальной пары (при $U_{\text{КБ}}=3\text{В}, I_{\text{Э}}=0,5\text{мА}$ ), %	$\delta h_{21Э}$	-	15	-	15	-	-
Разброс напряжения между базой и эмиттером тран- зисторов дифференциаль- ной пары (при $\varepsilon I_{\text{Э}}=0,5\text{мА},$ $U_{\text{КБ}}=3\text{В}$ ), мВ	$\delta U_{\text{БЭ}}$	-	3	-	10	-	-

Место для штампа  
ОТК



Место для штампа  
ПЗ

